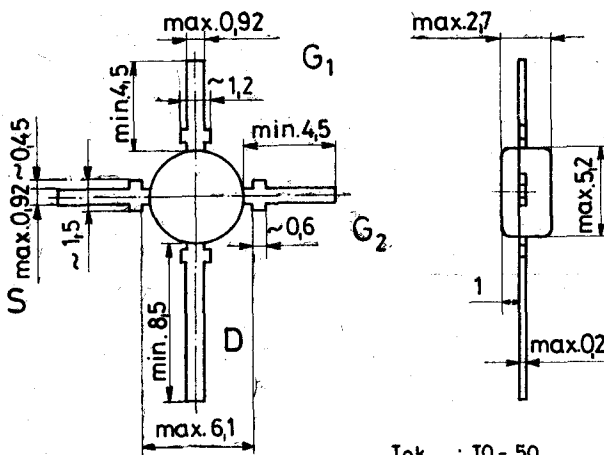


M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT

iv., Fóti út 56.

BF 966 N-csatornás két Gate-es MOS térhatású kiűritéses módú tetróda

Méreték mm-ben



Tok : T0 - 50
Tömeg: kb 0,1g

Ajánlott alkalmazás:

UHF hangoló egység bemenő- és keverőfokozatába.

Jellegzetes tulajdonságok:

Gate-et védő diódák beépítve.

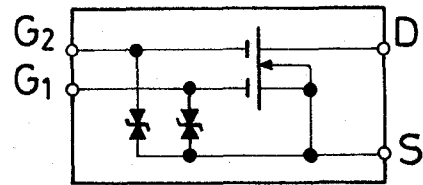
Nagy keresztmoduláció feldolgozás.

Alacsony zajtényező.

Nagy AGC átfogási tartomány.

Kicsi visszaható kapacitás.

Kicsi bemenő kapacitás.



MAXIMÁLIS HATÁRADATOK	JELÖLÉS	BF 966	EGYSÉG
Drain - Source feszültség	V_{DS}	20	V
Drain áram	I_D	30	mA
1-es és 2-es Gate által vezérelt Source áram csúcsértéke	$\pm I_G \ 1/2 \ DM$	10	mA
Teljes teljesítménydisszipáció $T_{amb} = 60^\circ C$	P_{tot}	200	mW
Csatorna hőmérséklete	T_C	150	$^\circ C$
Tárolási hőmérséklet	T_{stg}	- 55 ... + 150	$^\circ C$
HŐELLENÁLLÁS			
csatorna és környezet között 40x25x1,5mm egy oldalán 35 μm Cu fóliás nyomtatót áramköri lapra szerelve	R_{thCA}	450	K/W

STATIKUS JELLEMZŐK $T_{amb}=25^{\circ}C$ ha másként nincs megadva	JELÖLÉS	BF 964	EGYSÉG
Drain-Source letörési feszültség $I_D=10\mu A$, $-V_{G1S}=-V_{G2S}=4V$	$V_{(BR)DS}$	≥ 20	V
1-es Gate és Source közötti letörési feszültség $\pm I_{G2S}=10mA$, $V_{G2S}=V_{DS}=0$	$\pm V_{(BR)G1SS}$	≥ 6	V
2-es Gate és Source közötti letörési feszültség $\pm I_{G2S}=10mA$, $V_{G1S}=V_{DS}=0$	$\pm V_{(BR)G2SS}$	≥ 6	V
1-es Gate - Source visszáram $\pm V_{G1S}=5V$, $V_{G2S}=V_{DS}=0$	I_{G1SS}	≤ 50	nA
2-es Gate - Source visszáram $V_{G2S}=5V$, $V_{G1S}=V_{DS}=0$	I_{G2SS}	≤ 50	nA
Drain áram $V_{DS}=15V$, $V_{G1S}=0$, $V_{G2S}=4V$	I_{DSS}	$\geq 2 \leq 20$	mA
1-es Gate-Source zárófeszültség $V_{DS}=15V$, $V_{G2S}=4V$, $I_D=20\mu A$	$-V_{G1S(OFF)}$	$\leq 2,5$	V
2-es Gate-Source zárófeszültség $V_{DS}=15V$, $V_{G1S}=0$, $I_D=20\mu A$	$-V_{G2S(OFF)}$	$\leq 2,0$	V

DINAMIKUS JELLEMZŐK $V_{DS}=15V$, $I_D=10mA$, $V_{G2S}=4V$, $f=1MHz$ $T_{amb}=25^{\circ}C$ ha másként nincs megadva	JELÖLÉS	BF 964	EGYSÉG
Meredekség	Y_{fs}	$\geq 15 \quad 17$	mS
1-es Gate bemenő kapacitás	C_{iSSg1}	$2,5; \leq 30$	pF
2-es Gate bemenő kapacitás $V_{G1S}=0$, $V_{G2S}=4V$	C_{iSSg2}	1,2	pF
Visszaható kapacitás (G és S földelve)	C_{rSS}	$25; \leq 35$	pF
Kimenő kapacitás	C_{oSS}	$1,0; \leq 1,3$	pF
Teljesítmény erősítés $V_{DS}=15V$, $I_D=10mA$, $V_{G2S}=4V$ $g_G=2mS$, $g_L=0,5mS$, $f=200MHz$	G_{ps}	25	dB
Zajtényező $V_{DS}=15V$, $I_D=10mA$, $V_{G2S}=4V$ $g_G=2mS$, $f=200MHz$	F	10	dB

Schronk László

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető Ágazat Fejlesztése készséggel áll felhasználóink rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337).



M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT